

	<h2 style="color: red;">FCP190N60-GF102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP190N60-GF102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220-3
	Datenblätter:  FCP190N60-GF102.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 753 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N60-GF102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	753 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	199 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FCP190N60_GF102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20.2A (Tc) 208W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

FCP190N60-GF102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N60-GF102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N60-GF102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP190N60-GF102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP190N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP170N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO220</p>
 <p>FCP190N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP170N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO220</p>	 <p>FCP190N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>	 <p>FCP190N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP190N60-GF102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP190N60-GF102 Datenblatt	FCP190N60-GF102-Datenblätter	FCP190N60-GF102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP190N60-GF102
FCP190N60-GF102 Electronic	FCP190N60-GF102-Komponenten	FCP190N60-GF102-Verteiler	FCP190N60-GF102-Bild	FCP190N60-GF102-Teil
FCP190N60-GF102 Preis	FCP190N60-GF102 Hersteller	FCP190N60-GF102 Bild	FCP190N60-GF102 Aktie	FCP190N60-GF102 Inventar
FCP190N60-GF102 Neu	FCP190N60-GF102 Original	FCP190N60-GF102 garantiert	FCP190N60-GF102 RFQ	FCP190N60-GF102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited